

## Bezugszeichenliste

- 100 integrierter Schaltkreis
- 101 Silizium-Substrat
- 102 Kontaktierungselement
- 103 erster Feldeffekttransistor
- 104 zweiter Feldeffekttransistor
- 105 Gate-Bereich
- 106 Gate-Bereich
- 200 erste Layout-Ansicht eines integrierten Schaltkreises
- 201 erster Feldeffekttransistor
- 202 zweiter Feldeffekttransistor
- 203 gemeinsame Gate-Leitung
- 203a erste Gate-Komponente
- 203b zweite Komponente
- 203c erste Verlaufsrichtung
- 203d zweite Verlaufsrichtung
- 203e dritte Verlaufsrichtung
- 203f vierte Verlaufsrichtung
- 204 aktives Gebiet
- 204a erste Verlaufsrichtung
- 204b zweite Verlaufsrichtung
- 205 aktives Gebiet
- 205a erste Verlaufsrichtung
- 205b zweite Verlaufsrichtung
- 206 erstes quadratisches Kontaktierungselement
- 207 zweites quadratisches Kontaktierungselement
- 208 drittes quadratisches Kontaktierungselement
- 300 zweite Layout-Ansicht eines integrierten Schaltkreises
- 301 erstes rechteckförmiges Kontaktierungselement
- 301a dritte Verlaufsrichtung
- 301b vierte Verlaufsrichtung
- 302 zweites rechteckförmiges Kontaktierungselement
- 302a dritte Verlaufsrichtung
- 302b vierte Verlaufsrichtung

- 303 drittes rechteckförmiges Kontaktierungselement
- 303a dritte Verlaufsrichtung
- 303b vierte Verlaufsrichtung
- 401 Lithographie-Einrichtung
- 405 Silizium-Wafer
- 406a prozessierte Chips
- 406b unprozessierte Chips
  - 406c zu prozessierender Chip
- 407 Justieroptik
- 408 Retikel
- ) 409 Linse
- 410 Vorjustieroptik
- 411 Laserinterferometer
- 412 Spiegelfläche
- 413 xy-Tisch
- 414 Objektiv
- 415 Träger-Element
- 440 Flussdiagramm
- 450 erster Verfahrensschritt
- 455 zweiter Verfahrensschritt
- 460 dritter Verfahrensschritt
- 465 vierter Verfahrensschritt
- ) 470 fünfter Verfahrensschritt
- 475 sechster Verfahrensschritt